

УДК 512.542

## Приводимые $\omega$ -насыщенные формации с разрешимым дефектом $\leq 2$

В. Г. САФОНОВ, И. Н. САФОНОВА

Рассматриваются только конечные группы. Используются определения и обозначения, принятые в книгах [1, 2] и работе [3].

Пусть  $\omega$  — непустое множество простых чисел. Символом  $G_{\omega d}$  обозначается наибольшая нормальная в  $G$  подгруппа, у которой каждый композиционный фактор является  $\omega d$ -группой (если таких подгрупп в  $G$  нет, то полагают  $G_{\omega d} = 1$ ). Функция вида  $f : \omega \cup \{\omega'\} \rightarrow \{\text{формации}\}$  называется  $\omega$ -локальным спутником. Через  $LF_{\omega}(f)$  обозначается класс всех таких групп  $G$ , что  $G/G_{\omega d} \in f(\omega')$  и  $G/F_p(G) \in f(p)$  для любого  $p \in \omega \cap \pi(G)$ . Если формация  $\mathfrak{F}$  такова, что  $\mathfrak{F} = LF_{\omega}(f)$ , то говорят, что  $\mathfrak{F}$  является  $\omega$ -локальной формацией, а  $f$  —  $\omega$ -локальным спутником формации  $\mathfrak{F}$ . Формация  $\mathfrak{F}$  называется  $\omega$ -насыщенной, если ей принадлежит всякая группа  $G$  с  $G/L \in \mathfrak{F}$ , где  $L \subseteq O_{\omega}(G) \cap \Phi(G)$ . Как было показано в [3, 4], формация  $\mathfrak{F}$  является  $\omega$ -насыщенной тогда и только тогда, когда она  $\omega$ -локальна.

Пусть  $\mathfrak{X}$  — некоторая совокупность групп. Тогда через  $l^{\omega}\text{form}\mathfrak{X}$  обозначают  $\omega$ -насыщенную формацию, порожденную классом групп  $\mathfrak{X}$ , т.е. пересечение всех  $\omega$ -насыщенных формаций, содержащих  $\mathfrak{X}$ . При этом, если  $\mathfrak{X} = \{G\}$ , то формацию  $l^{\omega}\text{form}G$  называют однопорожденной  $\omega$ -насыщенной формацией. Для любых  $\omega$ -насыщенных формаций  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{H}$  полагают  $\mathfrak{M} \vee^{\omega} \mathfrak{H} = l^{\omega}\text{form}(\mathfrak{M} \cup \mathfrak{H})$ . Совокупность всех  $\omega$ -насыщенных формаций  $l^{\omega}$  с операциями  $\vee^{\omega}$  и  $\cap$  образует полную модулярную решетку.

Пусть  $\mathfrak{F}$  — некоторая  $\omega$ -насыщенная формация,  $\mathfrak{H}$  — произвольный класс групп. Формацию  $\mathfrak{F}$  называют минимальной  $\omega$ -насыщенной не  $\mathfrak{H}$ -формацией ( $\mathfrak{H}_{\omega}$ -критической формацией), если  $\mathfrak{F} \not\subseteq \mathfrak{H}$ , но все ее собственные  $\omega$ -насыщенные подформации из  $\mathfrak{F}$  содержатся в классе групп  $\mathfrak{H}$ .

Если  $\mathfrak{H}$  —  $\omega$ -насыщенная формация, то  $\mathfrak{H}$ -дефектом  $\omega$ -насыщенной формации  $\mathfrak{F}$  ( $\mathfrak{H}_{\omega}$ -дефектом формации  $\mathfrak{F}$ ) называют длину решетки  $\mathfrak{F}/^{\omega}\mathfrak{F} \cap \mathfrak{H}$   $\omega$ -насыщенных формаций, заключенных между  $\mathfrak{F} \cap \mathfrak{H}$  и  $\mathfrak{F}$ .  $\mathfrak{H}$ -Дефект  $\omega$ -насыщенной формации  $\mathfrak{F}$  обозначают через  $|\mathfrak{F} : \mathfrak{F} \cap \mathfrak{H}|$ . Если  $\mathfrak{H} = \mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{S}$ -дефект  $\omega$ -насыщенной формации называют её разрешимым дефектом.

$\omega$ -Насыщенную формацию  $\mathfrak{F}$  называют неприводимой, если  $\mathfrak{F} \neq l^{\omega}\text{form}(\cup_{i \in I} \mathfrak{X}_i) = \vee^{\omega}(\mathfrak{X}_i | i \in I)$ , где  $\{\mathfrak{X}_i | i \in I\}$  — набор всех собственных  $\omega$ -насыщенных подформаций из  $\mathfrak{F}$ . В противном случае формацию  $\mathfrak{F}$  называют приводимой.

В данной работе дается описание приводимых  $\omega$ -насыщенных формаций, имеющих разрешимый дефект  $\leq 2$ .

Следующие две леммы являются частным случаем лемм 5.2.7 и 5.2.8 [2, с.193-194].

**Лемма 1.** Пусть  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{F}$  и  $\mathfrak{H}$  —  $\omega$ -насыщенные формации, причем  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{F}$ . Тогда если  $m$  и  $n$  —  $\mathfrak{H}_{\omega}$ -дефекты формаций  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{F}$  соответственно, то  $m \leq n$ .

**Лемма 2.** Пусть  $\mathfrak{F}$ ,  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{X}$  и  $\mathfrak{H}$  —  $\omega$ -насыщенные формации, причем  $\mathfrak{F} = \mathfrak{M} \vee^{\omega} \mathfrak{X}$ . Тогда если  $m$ ,  $r$  и  $t$  —  $\mathfrak{H}_{\omega}$ -дефекты формаций  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{X}$  и  $\mathfrak{F}$  соответственно, то  $t \leq m + r$ .

**Лемма 3** [5]. Пусть  $\mathfrak{H}$  — формация классического типа,  $\mathfrak{F}$  — непустая  $\omega$ -насыщенная формация. Тогда если  $\mathfrak{F} \not\subseteq \mathfrak{H}$ , то в  $\mathfrak{F}$  имеется по крайней мере одна минимальная  $\omega$ -насыщенная не  $\mathfrak{H}$ -подформация.

**Лемма 4 [6, 7].** Тогда и только тогда  $\mathfrak{F}$  — минимальная  $\omega$ -локальная неразрешимая формация, когда  $\mathfrak{F} = l^{\omega}\text{form}G$ , где  $G$  — монолитическая группа с таким неабелевым монолитом  $P$ , что группа  $G/P$  разрешима.

Частным случаем леммы 2.1.6 [2, с.41] является следующая

**Лемма 5.** Пусть  $A$  — монолитическая группа с неабелевым монолитом,  $\mathfrak{M}$  — некоторая полуформация и  $A \in l\text{form}\mathfrak{M}$ . Тогда  $A \in \mathfrak{M}$ .

**Лемма 6 [8].** Пусть  $\mathfrak{F}$  —  $\omega$ -насыщенная формация. Тогда разрешимый дефект формации  $\mathfrak{F}$  равен 1 в том и только в том случае, когда  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X}$ , где  $\mathfrak{H}$  — минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая формация, а  $\mathfrak{X}$  — разрешимая  $\omega$ -насыщенная формация, при этом: 1) всякая разрешимая подформация из  $\mathfrak{F}$  входит в  $\mathfrak{X} \vee^{\omega} (\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S})$ ; 2) всякая неразрешимая  $\omega$ -насыщенная подформация  $\mathfrak{M}$  из  $\mathfrak{F}$  имеет вид  $\mathfrak{H} \vee^{\omega} (\mathfrak{M} \cap \mathfrak{S})$ .

*Доказательство. Необходимость.* Пусть  $\mathfrak{F}$  —  $\omega$ -насыщенная формация с разрешимым дефектом 1. Так как  $\mathfrak{F}$  неразрешимая формация, то по лемме 3 в  $\mathfrak{F}$  содержится некоторая минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая формация  $\mathfrak{H}$ . По условию леммы  $\mathfrak{X} = \mathfrak{F} \cap \mathfrak{S}$  — максимальная  $\omega$ -насыщенная подформация формации  $\mathfrak{F}$ . Поэтому  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X}$ .

*Достаточность.* Пусть  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X}$ , где  $\mathfrak{H}$  — минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая формация, а  $\mathfrak{X}$  — разрешимая  $\omega$ -насыщенная формация. Тогда ввиду леммы 2  $\mathfrak{S}$ -дефект формации  $\mathfrak{F}$  не превосходит 1. Так как  $\mathfrak{F} \not\subseteq \mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{F}$  —  $\omega$ -насыщенная формация разрешимого дефекта 1.

Докажем теперь вторую часть леммы. Поскольку  $\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}$  — максимальная  $\omega$ -насыщенная подформация в  $\mathfrak{H}$ , то в силу решеточного изоморфизма

$$\begin{aligned} \mathfrak{F}/^{\omega}(\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X} &= ((\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X}) /^{\omega} \mathfrak{H} /^{\omega}(\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X} \simeq \\ &\simeq \mathfrak{H} /^{\omega} \mathfrak{H} \cap ((\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X}) = \mathfrak{H} /^{\omega} \mathfrak{H} \cap \mathfrak{S} \end{aligned}$$

закключаем, что  $(\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X}$  — максимальная  $\omega$ -насыщенная подформация в  $\mathfrak{F}$ . Поскольку  $\mathfrak{F} \not\subseteq \mathfrak{S}$ , то любая разрешимая подформация из  $\mathfrak{F}$  содержится в  $(\mathfrak{H} \cap \mathfrak{S}) \vee^{\omega} \mathfrak{X}$ .

Допустим теперь, что в  $\mathfrak{F}$  имеется минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая подформация  $\mathfrak{H}_1$  и  $\mathfrak{H}_1 \neq \mathfrak{H}$ . Ввиду леммы 4 имеем  $\mathfrak{H}_1 = l^{\omega}\text{form}G$ , где  $G$  — монолитическая группа с таким неабелевым монолитом  $P$ , что группа  $G/P$  разрешима. Поскольку  $l\text{form}(\mathfrak{H} \cup \mathfrak{X})$  —  $\omega$ -насыщенная формация, то  $\mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X} \subseteq l\text{form}(\mathfrak{H} \cup \mathfrak{X})$ . Значит,  $G \in \mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X} \subseteq l\text{form}(\mathfrak{H} \cup \mathfrak{X})$ . Но тогда по лемме 5  $G \in \mathfrak{H} \cup \mathfrak{X}$ . Так как  $G$  неразрешимая группа, то  $G \in \mathfrak{H}$  и, следовательно,  $\mathfrak{H}_1 \subseteq \mathfrak{H}$ . Поскольку  $\mathfrak{H}_1 \not\subseteq \mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{H}$  —  $\mathfrak{S}_i$ -критическая формация, то  $\mathfrak{H}_1 = \mathfrak{H}$ . Противоречие. Таким образом, в формации  $\mathfrak{F}$  нет минимальных  $\omega$ -насыщенных неразрешимых подформаций, отличных от  $\mathfrak{H}$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{M}$  произвольная неразрешимая  $\omega$ -насыщенная подформация формации  $\mathfrak{F}$ . Тогда, согласно доказанному выше и лемме 3, имеем  $\mathfrak{H} \subseteq \mathfrak{M}$ . Поэтому

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= \mathfrak{M} \cap \mathfrak{F} = \mathfrak{M} \cap (\mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{X}) = \mathfrak{H} \vee^{\omega} (\mathfrak{M} \cap \mathfrak{X}) = \\ &= \mathfrak{H} \vee^{\omega} (\mathfrak{M} \cap (\mathfrak{F} \cap \mathfrak{S})) = \mathfrak{H} \vee^{\omega} (\mathfrak{M} \cap \mathfrak{S}). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

**Теорема.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — приводимая  $\omega$ -насыщенная формация. Тогда и только тогда разрешимый дефект формации  $\mathfrak{F}$  равен 2, когда  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет одному из следующих условий:

1)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H}_1 \vee^{\omega} \mathfrak{H}_2 \vee^{\omega} \mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{H}_1$  и  $\mathfrak{H}_2$  — различные минимальные  $\omega$ -насыщенные неразрешимые формации;

2)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee^{\omega} \mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{H}$  — неприводимая  $\omega$ -насыщенная формация разрешимого дефекта 2,  $\mathfrak{M} \not\subseteq \mathfrak{H}$ .

*Доказательство. Необходимость.* Пусть  $\mathfrak{X}$  — такая максимальная  $\omega$ -насыщенная подформация  $\mathfrak{F}$ , что  $|\mathfrak{X} : \mathfrak{X} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ . По лемме 6  $\mathfrak{X} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{H}_1$  — минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая формация,  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ . Если в  $\mathfrak{F}$  имеется еще одна минимальная  $\omega$ -насыщенная неразрешимая подформация  $\mathfrak{H}_2$ , отличная от  $\mathfrak{H}_1$ , то в силу леммы 6  $\mathfrak{H}_2 \not\subseteq \mathfrak{X}$ . Значит,  $\mathfrak{F} = \mathfrak{X} \vee^\omega \mathfrak{H}_2 = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{H}_2 \vee^\omega \mathfrak{M}$ , т.е. формация  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет условию 1) теоремы.

Пусть теперь в  $\mathfrak{F}$  нет отличных от  $\mathfrak{H}_1$  минимальных  $\omega$ -насыщенных неразрешимых формаций. Поскольку  $\mathfrak{F}$  — приводимая  $\omega$ -насыщенная формация, то в  $\mathfrak{F} \setminus \mathfrak{X}$  найдется такая группа  $G$ , что  $\mathfrak{R} = {}^l\text{form} G \neq \mathfrak{F}$ . Понятно, что  $\mathfrak{F} = \mathfrak{X} \vee^\omega \mathfrak{R}$ . Ввиду леммы 2  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega \leq 2$ . Поскольку  $\mathfrak{F} = \mathfrak{X} \vee^\omega \mathfrak{R}$  и  $|\mathfrak{X} : \mathfrak{X} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ , то  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega \neq 0$ . Допустим, что  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ . Тогда по лемме 6  $\mathfrak{R} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_1$ , где  $\mathfrak{M}_1 \subseteq \mathfrak{S}$ . Значит,

$$\mathfrak{F} = \mathfrak{X} \vee^\omega \mathfrak{R} = (\mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}) \vee^\omega (\mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_1) = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega (\mathfrak{M} \vee^\omega \mathfrak{M}_1).$$

Но тогда, в силу леммы 2, получим  $|\mathfrak{F} : \mathfrak{F} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ . Противоречие. Поэтому  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 2$ . Заметим, что  $\mathfrak{H}_1 \subseteq \mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{M} \not\subseteq \mathfrak{R}$ , так как в противном случае  $\mathfrak{X} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{R}$ . Последнее противоречит максимальнойности формации  $\mathfrak{X}$ .

Если  $\mathfrak{R}$  — неприводимая  $\omega$ -насыщенная формация, то

$$\mathfrak{F} = \mathfrak{X} \vee^\omega \mathfrak{R} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} \vee^\omega \mathfrak{R} = \mathfrak{M} \vee^\omega \mathfrak{R}$$

и формация  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет условию 2) теоремы.

Пусть  $\mathfrak{R}$  — приводимая  $\omega$ -насыщенная формация. Как известно (см. замечание 3 [3, с.127]), любая однопорожденная  $\omega$ -насыщенная формация содержит конечное число разрешимых  $\omega$ -насыщенных подформаций. Пусть  $k$  — число разрешимых  $\omega$ -насыщенных подформаций формации  $\mathfrak{R}$ . Индукцией по  $k$  покажем, что  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет условию 2).

Обозначим через  $\mathfrak{L}$  такую максимальную  $\omega$ -насыщенную подформацию формации  $\mathfrak{R}$ , что  $|\mathfrak{L} : \mathfrak{L} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ . Если  $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} \not\subseteq \mathfrak{L}$ , то  $\mathfrak{L} \vee^\omega (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}) = \mathfrak{R}$  и  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ , что невозможно. Значит,  $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{L}$ . В силу леммы 6  $\mathfrak{L} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_2$ , где  $\mathfrak{M}_2 \subseteq \mathfrak{S}$ . Поскольку  $\mathfrak{R}$  — приводимая  $\omega$ -насыщенная формация, то в  $\mathfrak{R} \setminus \mathfrak{L}$  найдется такая группа  $A$ , что  $\mathfrak{R}_1 = {}^l\text{form} A \neq \mathfrak{R}$ . Тогда  $\mathfrak{R} = \mathfrak{L} \vee^\omega \mathfrak{R}_1$ . Если  $|\mathfrak{R}_1 : \mathfrak{R}_1 \cap \mathfrak{S}|^\omega < 2$ , то в силу леммы 2 имеем  $|\mathfrak{R} : \mathfrak{R} \cap \mathfrak{S}|^\omega = 1$ . Противоречие. Значит,  $|\mathfrak{R}_1 : \mathfrak{R}_1 \cap \mathfrak{S}|^\omega = 2$ . Так как в  $\mathfrak{F}$  нет отличных от  $\mathfrak{H}_1$  минимальных  $\omega$ -насыщенных неразрешимых формаций, то с учетом леммы 3 имеем  $\mathfrak{H}_1 \subseteq \mathfrak{R}_1$ . Поскольку  $\mathfrak{L}$  максимальная  $\omega$ -насыщенная подформация  $\mathfrak{R}$ , то  $\mathfrak{M}_2 \not\subseteq \mathfrak{R}_1$ , так как в противном случае  $\mathfrak{L} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_2 \subseteq \mathfrak{R}_1 \subseteq \mathfrak{R}$ . Поэтому число разрешимых  $\omega$ -насыщенных подформаций формации  $\mathfrak{R}_1$  меньше  $k$ . Значит, если  $\mathfrak{R}_1$  — приводимая  $\omega$ -насыщенная формация, то по индукции мы можем считать, что  $\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{H} \vee^\omega \mathfrak{M}_3$ , где  $\mathfrak{H}$  — неприводимая  $\omega$ -насыщенная формация разрешимого дефекта 2. Тогда

$$\begin{aligned} \mathfrak{F} &= \mathfrak{R} \vee^\omega \mathfrak{M} = \mathfrak{L} \vee^\omega \mathfrak{R}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_2 \vee^\omega \mathfrak{R}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} = \\ &= \mathfrak{H} \vee^\omega (\mathfrak{M} \vee^\omega \mathfrak{M}_2 \vee^\omega \mathfrak{M}_3) = \mathfrak{H} \vee^\omega \mathfrak{M}_4, \end{aligned}$$

т.е. формация  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет условию 2) теоремы.

Если  $\mathfrak{R}_1$  — неприводимая  $\omega$ -насыщенная формация, то

$$\begin{aligned} \mathfrak{F} &= \mathfrak{R} \vee^\omega \mathfrak{M} = \mathfrak{L} \vee^\omega \mathfrak{R}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} = \mathfrak{H}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_2 \vee^\omega \mathfrak{R}_1 \vee^\omega \mathfrak{M} = \\ &= \mathfrak{R}_1 \vee^\omega (\mathfrak{M}_2 \vee^\omega \mathfrak{M}) = \mathfrak{R}_1 \vee^\omega \mathfrak{M}_5 \end{aligned}$$

и формация  $\mathfrak{F}$  также удовлетворяет условию 2). Теорема доказана.

В случае, когда  $\omega = \{p\}$  из теоремы получаем

**Следствие 1.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — приводимая  $p$ -насыщенная формация. Тогда и только тогда разрешимый дефект формации  $\mathfrak{F}$  равен 2, когда  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет одному из следующих условий:

1)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H}_1 \vee {}^p\mathfrak{H}_2 \vee {}^p\mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{H}_1$  и  $\mathfrak{H}_2$  — различные минимальные  $p$ -насыщенные неразрешимые формации;

2)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee {}^p\mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{H}$  — неприводимая  $p$ -насыщенная формация разрешимого дефекта 2,  $\mathfrak{M} \not\subseteq \mathfrak{H}$ .

Если  $\omega$  — множество всех простых чисел, из теоремы вытекает

**Следствие 2.** Пусть  $\mathfrak{F}$  — приводимая насыщенная формация. Тогда и только тогда разрешимый дефект формации  $\mathfrak{F}$  равен 2, когда  $\mathfrak{F}$  удовлетворяет одному из следующих условий:

1)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H}_1 \vee {}_1\mathfrak{H}_2 \vee {}_1\mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{H}_1$  и  $\mathfrak{H}_2$  — различные минимальные насыщенные неразрешимые формации;

2)  $\mathfrak{F} = \mathfrak{H} \vee {}_1\mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{H}$  — неприводимая насыщенная формация разрешимого дефекта 2,  $\mathfrak{M} \not\subseteq \mathfrak{H}$ .

**Abstract.** The description of reducible partially saturated formations of finite groups with the soluble defect  $\leq 2$  is obtained.

### Литература

1. Л. А. Шеметков, А. Н. Скиба, *Формации алгебраических систем*, Москва, Наука, 1989.
2. А. Н. Скиба, *Алгебра формаций*, Минск, Беларуская навука, 1997.
3. А. Н. Скиба, Л. А. Шеметков, *Кратко  $\omega$ -локальные формации и классы Фиттинга конечных групп*, Матем. труды, 2, № 2 (1999), 114–147.
4. А. Н. Скиба, Л. А. Шеметков, *О частично локальных формациях*, Докл. АН Беларуси, 39, № 3 (1995), 9–11.
5. И. Н. Сафонова, *О существовании  $\mathfrak{H}_\omega$ -критических формаций*, Вопросы алгебры, Гомель, Гомельский ун-т, Вып. 15 (1999), 121–129.
6. В. Н. Рыжик, *О критических  $p$ -локальных формациях*, Препринт / Гомель, Гомельский госуниверситет, № 58 (1997).
7. И. Н. Сафонова, *К теории  $\mathfrak{H}_\omega$ -критических формаций конечных групп*, Вопросы алгебры, Гомель, Гомельский ун-т, Вып. 17 (2001), 124–133.
8. И. Н. Сафонова, *О частично насыщенных формациях с заданной системой подформаций*, IX Белорусская математическая конференция, Тез. докл., Ч. 2, Гродно, (2004), 47–48.